

A3N1001~1008

バイアスティ

特長

- ・広帯域
- ・低挿入損失

用途

- ・高周波半導体評価
- ・光通信



絶対最大定格

項目	定格	単位
最大バイアス電圧	±30	V _{dc}
最大バイアス電流	±0.5	A
動作温度	0 to +60	℃

規格

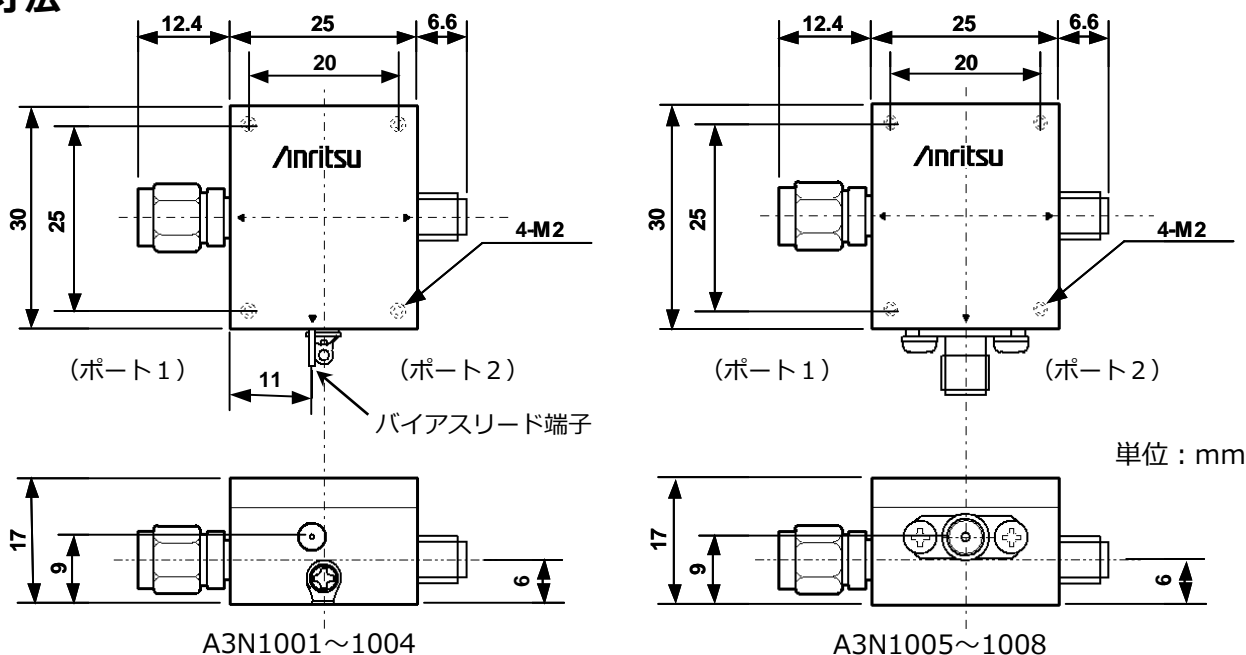
T_a=25℃, Z_{in}=50Ω, Z_{out}=50Ω

項目	条件	規格			単位
		min.	typ.	max.	
帯域	-3dB	100k	—	20G	Hz
インサージョンロス	100kHz	—	2	3	dB
	200kHz	—	0.5	—	
	1GHz	—	0.2	—	
	10GHz	—	1	—	
	20GHz	—	2	3	
リターンロス	帯域内	12	20	—	dB
立上り, 立下り時間	*1	—	18	20	ps

*1: $T_r, T_f = (T_m^2 - T_s^2 - T_i^2)^{1/2}$

T_m: オシロスコープによる測定値、T_s: オシロスコープの T_r, T_f、T_i: 信号源の T_r, T_f

外形寸法



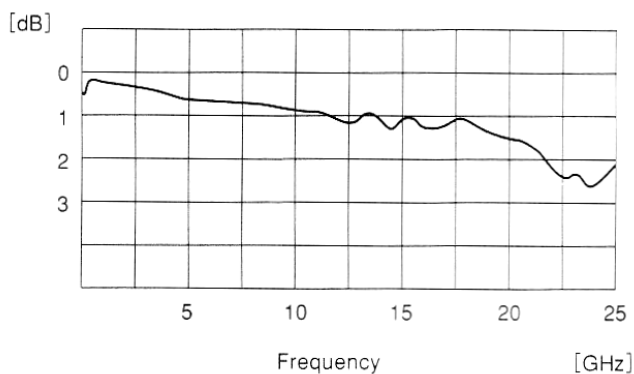
コネクタ

形名	ポート1	ポート2	バイアス
A3N1001	K-M	K-F	半田付け 端子
A3N1002	K-F	K-M	
A3N1003	K-F	K-F	
A3N1004	K-M	K-M	

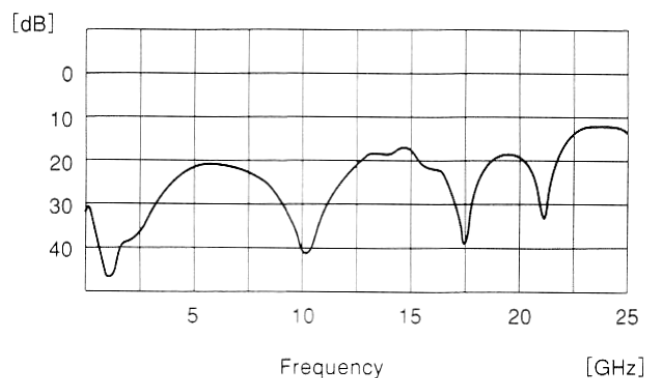
形名	ポート1	ポート2	バイアス
A3N1005	K-M	K-F	SMA-F
A3N1006	K-F	K-M	
A3N1007	K-F	K-F	
A3N1008	K-M	K-M	

特性例

伝送特性



反射特性

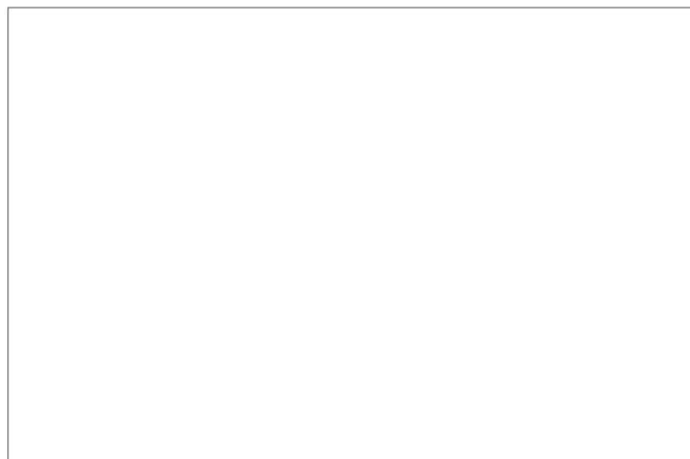


アンリツ株式会社

アンリツ株式会社
センシング&デバイスカンパニー 国内営業部
〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5
TEL 046-296-1228 FAX 046-296-1254

URL: <https://www.anritsu.com/sensing-devices>

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。